# PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

# TRANSLATION INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference  13584 Ko/mk	FOR FURTHER ACTIO	ON See Form PCT/IPEA/416				
International application No.	International filing date (day	ay/month/year) Priority date (day/month/year)				
PCT/DE2005/000559 30.03.20		01.04.2004				
International Patent Classification (IPC) or i	national classification and IPC					
G01L9/00 H01L51/20		9/00				
Applicant INFINEON TECHNOLOGI	ES AG					
This report is the international prunder Article 35 and transmitted to		established by this International Preliminary Examining Authority icle 36.				
2. This REPORT consists of a total c	of	sheets, including this cover sheet.				
3. This report is also accompanied by	y ANNEXES, comprising:					
a. (sent to the applicant of	and to the International Bureau)	) a total of 4 sheets, as follows:				
sheets of the des	cription, claims and/or drawings	s which have been amended and are the basis for this report and/or is Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative				
the disclosure in	persede earlier sheets, but which the international application as	h this Authority considers contain an amendment that goes beyond is filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental				
Box.						
b. (sent to the Internation	nal Bureau only) a total of (indic	cate type and number of electronic carrier(s))				
		containing a sequence listing and/or tables				
related thereto, in comp Section 802 of the Admi		licated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see				
4. This report contains indications re	lating to the following items:					
abla	the report					
	the report					
Box No. II Priority	i.					
Box No. III Non-est	ablishment of opinion with regar	ard to novelty, inventive step and industrial applicability				
	unity of invention					
1	Box No. V  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: citations and explanations supporting such statement					
Box No. VI Certain						
Box No. VII Certain	defects in the international appli	lication				
Box No. VIII Certain	observations on the international	al application				
Date of submission of the demand	Date	e of completion of this report				
Name and mailing address of the IPEA/EP	Auth	horized officer				
Enceimile No	Tele	ephone No.				

International application No.
PCT/DE2005/000559

Box	No. I		Basis of the report			
1.			to the language, this report is based on the internation der this item.	al application in the language in	which it was filed, unless otherwise	
	This report is based on translations from the original language into the following language which is the language of a translation furnished for the purposes of:					
	international search (Rule 12.3 and 23.1(b))					
			publication of the international application (Rule 12.4)			
			international preliminary examination (Rule 55.2 and/c			
2.	rece	iving O <sub>j</sub> report):		report is based on (replacement se referred to in this report as "o	theets which have been furnished to the riginally filed" and are not annexed to	
			ternational application as originally filed/fornished			
			escription:	•	ne originally filed/famoiched	
		pages	1-20		as originally filed/furnished	
		pages	*	received by this Authority on		
	<b>K</b> ramana	pages	*	received by this Authority on		
	$\boxtimes$	the cla	aims:			
		nos.			as originally filed/furnished	
		nos.*		as amended (togethe	r with any statement) under Article 19 23.12.2005 with letter	
		nos.*	1-15	received by this Authority on		
;		nos.*	·	received by this Authority on		
	$\boxtimes$	the dr	awings:			
		sheets			as originally filed/furnished	
		sheets				
		sheets				
	$\Box$		uence listing and/or any related table(s) – see Suppleme			
				chair box iterating to bedreine t	<b></b> -	
3.		The a	amendments have resulted in the cancellation of:			
			the description, pages			
			the claims, nos.		<u> </u>	
			the drawings, sheets/figs			
			the sequence listing (specify):			
			any table(s) related to sequence listing (specify):			
4.		This they	report has been established as if (some of) the amend have been considered to go beyond the disclosure as fil	lments annexed to this report and led, as indicated in the Suppleme	d listed below had not been made, since ntal Box (Rule 70.2(c)).	
			the description, pages			
			the claims, nos.			
			the drawings, sheets/figs			
			the sequence listing (specify):			
			any table(s) related to sequence listing (specify):			
*	If it	 em 4 ar	oplies, some or all of those sheets may be marked "sup	<del></del>		

International application No.
PCT/DE2005/000559

Box No. V Reasoned statement under A citations and explanations st			rticle 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; pporting such statement		
1.	Statement			•	
	Novelty	(N)	Claims	1-15	YES
			Claims		NO
	Inventive	e step (IS)	Claims	1-15	YES
			Claims		NO NO
	Industria	l applicability (IA)	Claims	1-15	YES
			Claims		NO
				·	

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Reference is made to the following document:

D1: SOMEYA T ET AL.: "Integration of organic fiel-effect transistors and rubbery pressure sensors for artificial skin applications" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2003. IEDM. TECHNICAL DIGEST. WASHINGTON, DC, DEC 8-10, 2003, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8 December 2003 (2003-12-08), pages 203-206 XP010683992 ISBN: 0-7803-7872-5

Document D1 is considered to be the closest prior art to the subject matter of claim 1. It discloses (the references between parentheses refer to this document):

a force sensor based on an organic field effect transistor that is supplied to a substrate and has an active layer which acts as a force-sensitive layer and is composed of pentazene, in which a mechanical force which acts on the transistor is transmitted to the active layer which brings about a change in the source-drain voltage which corresponds to this force, or in the source-drain current of the organic field-effect transistor, which changes can be respectively sensed as a measurement

International application No.
PCT/DE2005/000559

Box No. V

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

variable for the acting force.

The subject matter of claim 1 therefore differs from the known force sensor in that the active layer which acts as sensitive to the force is arranged between the source electrode and the drain electrode of the transistor.

The subject matter of claim 1 is thus novel (PCT Article 33(2)).

The problem addressed by the present invention can therefore be considered that of making possible a force sensor which can be manufactured cost effectively.

The solution to this problem, as proposed in claim 1 of the present application involves an inventive step for the following reasons (PCT Article 33(3)):

The international search report citations do not contain any teaching which would prompt a person skilled in the art concerned with the abovementioned problem to change or adapt the force sensor according to document D1 in order to arrive at anything covered by claim 1.

Claims 2-15 are dependent on claim 1 and thus also meet the PCT requirements for novelty and inventive step.

International application No.
PCT/DE2005/000559

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Certa	in published documents (Rule 70.10)				
	Application No. Patent No.		Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid clai (day/month/year)
	I WON (10)				
			•		
					•
				•	
					•
			•		
Non-	-written disclosures (Rule 70.9)				
Non	-written disclosures (Rule 70.9)  Kind of non-written disclosure		Date of non-written di (day/month/yea		Date of written disclosure ferring to non-written disclosure (day/month/year)
Non-	Kind of non-written disclosure				ferring to non-written disclosure
Non	Kind of non-written disclosure				ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure				ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure				ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea		ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea		ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea		ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea		ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea		ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea	· ·	ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea		ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea	· ·	ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ferring to non-written disclosure
Non-	Kind of non-written disclosure		(day/month/yea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ferring to non-written disclosure

International application No.
PCT/DE2005/000559

Supplemental Box

In case the space in any of the preceding boxes is not sufficient. Continuation of:

Box VI

Reference is made to the following document:

D7: WO 2004/077500 A (INFM INSTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA; BONFIGLIO, ANNALI)

10 September 2004 (2004-09-10)

It is to be noted that the priority date (2002-02-28) and the application date (2004-02-27) of the international patent application D7 occur before the priority date of the present application and that the subject matter of claims 1-9 of the present application is disclosed by this document (see the corresponding text references given in the international search report).

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

				<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 13584 Kolmk		WEITERES VORG	EHEN ,	siehe Formblatt PCT/IPEA/416		
Internationales Aktenzeichen Internationales A PCT/DE2005/000559 30.03.2005			edatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatWahr) 01.04.2004		
1	Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. G01L9/00 H01L51/20 G06F3/033 G06K9/00					
	elder INEON TECHNO	DLOGIES AG et	al.			
1.	<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> </ol>					
2.	Dieser BERICHT	umfaßt insgesar	nt 5 Blätter einschließl	ich dieses Deckblatts.		
3.	Außerdem lieger	n dem Bericht AN	LAGEN bei; diese umfa	assen		
	_				iter; dabei handelt es sich um	
	a. (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 4 Blätter; dabei handelt es sich um  Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).					
	Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebene Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.					
	b. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie Im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).					
4.	Dieser Bericht ei	nthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:			
	⊠ Feld Nr. I	Grundlage des l	Berichts			
	☐ Feld Nr. II	Priorität				
			er Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche			
	☐ Feld Nr. IV	Mangelnde Einh	neitlichkeit der Erfindun	g		
	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35 und der gewerblichen Anwendbarkelt; U			5(2) hinsichtlich der Neul Unterlagen und Erklärun	heit, der erfinderischen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung	
	☑ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen					
	☐ Feld Nr. VII	Bestimmte Män	gel der internationalen	Anme <b>ldu</b> ng		
	Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internatio			nalen Anmeldung		
Datu	Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dleses Berichts		
12.	12.12.2005			11.08.2006		
	Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen			Bevollmächtigter Bediens	stater States Petracent	
Pröfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl  Fax: +31 70 340 - 3016			as	Debesset, S Tel. +31 70 340-4802	Santa Oliver a and a state of the state of t	
1						

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000559

-	Feld Nr. I Grundlage des Berichts					
1.	. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf					
	☐ der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.					
	einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:  internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b))  Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a))  internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a))					
2.	2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzbla Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen die "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):	=				
	Beschreibung, Seiten					
•	1-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	Ansprüche, Nr.					
	1-15 eingegangen am 23.12.2005 mit Schreiben vom 23.12.2005					
	Zeichnungen, Blätter					
	1/5-5/5 in der ursprünglich eingereichten Fassung					
	☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld bei Sequenzprotokoll	treffend das				
3.	<ul> <li>Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:</li> <li>Beschreibung: Seite</li> <li>Ansprüche: Nr.</li> <li>Zeichnungen: Blatt/Abb.</li> <li>Sequenzprotokoll (genaue Angaben):</li> <li>etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):</li> </ul>					
4.	<ul> <li>Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründ Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassu (Regel 70.2 c)).</li> <li>Beschreibung: Seite</li> <li>Ansprüche: Nr.</li> <li>Zeichnungen: Blatt/Abb.</li> <li>Sequenzprotokoll (genaue Angaben):</li> <li>etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):</li> </ul>	den nach				
	* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit d	ler Bemerkung				

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000559

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-15

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-15

Nein: Ansprüche:

Ja:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

## Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) und / oder

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

siehe Beiblatt

### Zu Punkt V

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: SOMEYA T ET AL: "Integration of organic field-effect transistors and rubbery pressure sensors for artificial skin applications" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2003. IEDM. TECHNICAL DIGEST. WASHINGTON, DC, DEC 8 - 10, 2003, NEW YORK, NY: IEEE, US, 8. Dezember 2003 (2003-12-08), Seiten 203-206, XP010683992 ISBN: 0-7803-7872-5

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

einen Kraftsensor auf der Basis auf einem Substrat aufgebrachten organischen Feldeffekttransistors mit einem als kraftsensitive Schicht wirkenden aktiven Schicht aus Pentazen, bei dem sich eine auf den Transistor einwirkende mechanische Kraft auf die aktive Schicht überträgt, die eine dieser Kraft entsprechende Änderung der Source-Drainspannung oder des Source-Drainstroms des organischen Feldeffekttransistors verursacht, die jeweils als Messgröße für die einwirkende Kraft erfassbar sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten Kraftsensor dadurch, daß die als Kraftsensitive einwirkende aktive Schicht zwischen der Sourceelektrode und der Drainelektrode des Transistors angeordnet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, einen kostengünstig herstellbaren Kraftsensor zu ermöglichen.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

In den im internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumenten findet sich keine Lehre,

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000559

die den mit der obengenännten Aufgabe befassten Fachmann veranlassen würde, den Kraftsensor nach Dokument D1 so zu ändern oder anzupassen, um zu etwas zu gelangen, was unter den Anspruch 1 fällt.

Die Ansprüche 2-15 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

### Zu Punkt VI

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D7: WO 2004/077500 A (INFM ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA; BONFIGLIO, ANNALI) 10. September 2004 (2004-09-10)

Es muss festzustellen, daß der Prioritätstag (2002-02-28) und der Anmeldetag (2004-02-27) des internationalen Patentanmeldung D7 vor dem Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung liegt, und daß der Gegenstand der Ansprüche 1-9 der vorliegenden Anmeldung von diesem Dokument offenbart wird (siehe die entsprechenden im internationalen Recherchenbericht angegebenen Textstellen).

(4

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

23.12.2005

## Neuer Patentansprüche

- Kraftsensor auf der Basis auf einem Substrat (1; 11) aufgebrachten organischen Feldeffekttransistors (10) mit einer als kraftsensitive Schicht wirkenden aktiven Schicht (5) aus Pentazen, Fluoren oder Thiopen zwischen seiner Sourceelektrode (7) und seiner Drainelektrode (4), bei dem sich eine auf den Transistor einwirkende mechanische Kraft auf die aktive Schicht (5) überträgt, die eine dieser Kraft entsprechende Änderung der Source-Drainspannung oder des Source-Drainstroms (ID) des organischen Feldeffekttransistors (10) verursacht, die jeweils als Messgröße (Vmess, Imess) für die einwirkende Kraft erfassbar sind.
- 3. Kraftsensor nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Polymerfolie des Substrats (1) insbesondere Polyethylen-Naphthalat (PEN), Polyethylen-Terephthalat (PET), Polyimid (PI), Polycarbonat und/oder Polyethenether-Ketone (PEEK) aufweist.
- 4. Kraftsensor nach einem der vorangehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, dass die erfasste Messgröße (Vmess) die Drain-Source-Spannung des organischen Feldeffekttransistors (10) ist, wobei diesem zum Messzeitpunkt eine konstante Gate-Source-Spannung (Vsteuer) und ein konstanter Drain-Strom (Isteuer) anliegen.

1

4

ř.

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

23.12,2005

- 5. Kraftsensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da durch gekennzeichnet, dass die erfasste Messgröße der Drainstrom ( $I_{mess}$ ) des organischen Feldeffekttransistors (10) ist, wobei diesem zum Messzeitpunkt eine konstante Gate-Source-Spannung ( $V_{steuer1}$ ) und eine konstante Drain-Source-Spannung ( $V_{steuer2}$ ) anliegen.
- 6. Drucksensor unter Verwendung wenigstens eines Kraftsensors nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Substrat als deformierbare Membran (11) gestaltet ist und die Messgröße dem Biegezustand der Membran entspricht.
- 7. Ein- oder zweidimensionaler Positionssensor zur Messung der Position einer mechanischen Krafteinwirkung entlang einer Linie oder innerhalb einer Fläche unter Verwendung einer Vielzahl von Kraftsensoren (10<sub>1</sub>, 10<sub>2</sub>, ..., 10<sub>n</sub>) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Kraftsensoren (10<sub>1</sub>, 10<sub>2</sub>, ..., 10<sub>n</sub>) in regelmäßigen Abständen zueinander in Form einer ein- oder zweidimensionalen Matrix auf einem gemeinsamen Substrat angeordnet sind.
- 8. Eindimensionaler Positionssensor nach Anspruch 7,
  d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
  dass eine Ansteuer- und Messeinheit (20) mit den Drain- oder

  Sourceanschlüssen aller Feldeffekttransistoren zur Ansteuerung und Erfassung der Position der Krafteinwirkung verbunden
  bzw. verbindbar ist.
- 9. Zweidimensionaler Positionssensor nach Anspruch 8,
  30 bei dem die organischen Feldeffekttransistoren in Zeilen und
  Spalten angeordnet sind und eine Ansteuer- und Messeinheit
  (20) mit den Drain- oder Sourceanschlüssen aller Spalten zur
  Ansteuerung und Erfassung der Spaltenposition der Krafteinwirkung und ein Zeilendecoder (21) mit den Gateanschlüssen
  35 der organischen Feldeffekttransistoren zur zeilenweisen Auswahl und Ansteuerung der organischen Feldeffekttransistoren
  verbunden bzw. verbindbar sind.

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

3 23.12.2005

- 10. Fingerabdrucksensor unter Verwendung einer Vielzahl von in Form einer in Zeilen und Spalten untergliederten zweidimensionalen Matrix in regelmäßigen Abständen auf einem gemeinsamen Substrat angeordneten Kraftsensoren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei eine Ansteuer- und Messeinheit (70) mit den Drain- oder Sourceanschlüssen der organischen Feldeffekttransistoren in allen Spalten zur Ansteuerung und Erfassung der Spaltenposition der Krafteinwirkung und ein Zeilendecoder (21) mit den Gateanschlüssen der organischen Feldeffekttransistoren aller Zeilen zur zeilenweisen Auswahl und Erfassung der Position der Krafteinwirkung in Zeilenrichtung verbunden bzw. verbindbar sind.
  - 11. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 10,
- dass wenigstens eine schweißresistente Schutzschicht (30, 31; 32) als Schutz gegen Eindringen von Wasser und organischen Kontaminationen über der aktiven Schicht (5) der organischen Feldeffekttransistoren vorgesehen ist.

20

12. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 11, dad urch gekennzeich net, dass die Schutzschicht aus einem perfluorierten Material besteht.

25

- 13. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 11,
  d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
  dass eine erste Schutzschicht (30) aus einem hydrophoben Material und eine zweite Schutzschicht (31) aus einem hydrophilen Polymer besteht, das als Diffusionsbarriere gegen lipophile Verunreinigungsstoffe wirkt.
  - 14. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
- dass die erste Schutzschicht (30) die zweite Schutzschicht (31) bedeckt.

Internationale Patentanmeldung Nr. PCT/DE2005/000559
Infineon Technologies AG

13584

23.12.2005

15. Fingerabdrucksensor nach Anspruch 13, da durch gekennzeich net, dass die zweite Schutzschicht (31) die erste Schutzschicht (30) bedeckt.

5